

独自プロセスで低オン抵抗・高アクティブクランプ耐量を両立

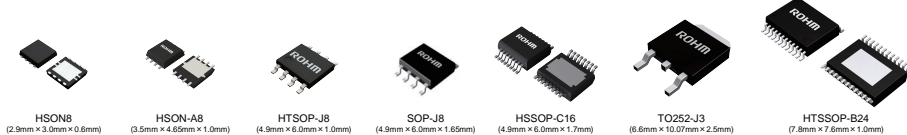
Original Processes Provide Both Low ON Resistance and Superior Active Clamp Capability



車載IPD 開発ラインアップ

Development Lineups of for Automotive IPDs

BV1Lxxx, BM2Lxxx, BD8Lxxx, BV1Hxxx Series



Features

Low-Side Switches

■ 低オン抵抗・高アクティブクランプ耐量両立

Low ON resistance with high active clamp capability

■ 低電圧オン抵抗保証 (IN=3V)

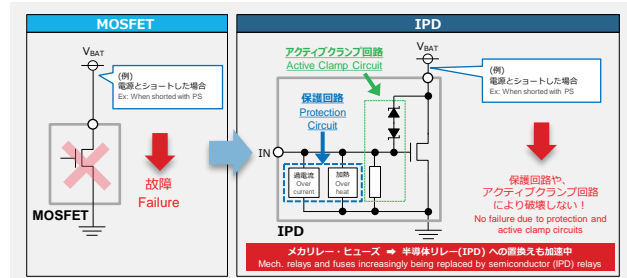
Guaranteed low voltage ON resistance (IN=3V)

■ 出力端子 : HBM±8000V

High output pin ESD resistance : ±8000V HBM

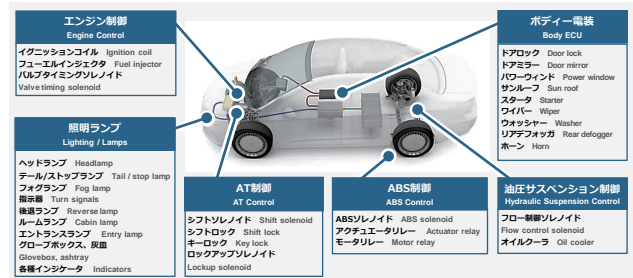
高性能半導体パワースイッチ

High Performance Semiconductor Power Switch



Applications

Applications



Applications

■ 車載機器全般

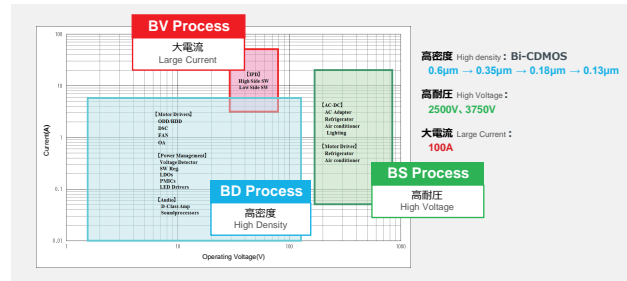
Automotive systems

■ 産機機器全般

Industrial equipment

LSIプロセスマップ

ICs Process Map



開発状況

Development Roadmap

Process	ローサイドスイッチ Low-side Switch				ハイサイドスイッチ High-side Switch		
	1ch	2ch	4ch	8ch	1ch	2ch	4ch
New 0.25μm Bi-CVDMOS (Spin Gate Trench MOS)					2mΩ 4mΩ 8mΩ	8mΩ 20mΩ	
New 0.35μm Bi-CVDMOS (Spin Gate Trench MOS)	10mΩ 25mΩ 44mΩ 80mΩ 150mΩ	80mΩ 150mΩ			20mΩ 45mΩ 90mΩ 150mΩ 180mΩ	45mΩ 70mΩ 90mΩ 150mΩ	180mΩ
0.6μm CVDMOS (CMOS + Vertical DMOS)	28mΩ 45mΩ 85mΩ	105mΩ 120mΩ 150mΩ 300mΩ 350mΩ			90mΩ		
Bi-CDMOS (Bipolar + CMOS + DMOS)	350mΩ		750mΩ	600mΩ 700mΩ 750mΩ	500mΩ		

■ : MP / CS
■ : Under Development
■ : Planned